

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : 10-116809

(43)Date of publication of application : 06.05.1998

(51)Int.Cl.

H01L 21/304

B08B 3/12

C11D 7/26

C11D 7/50

H01L 21/027

(21)Application number : 08-270353

(71)Applicant : OMI TADAIRO
URUTORA CLEAN TECHNOL
KAIHATSU KENKYUSHO:KK

(22)Date of filing : 11.10.1996

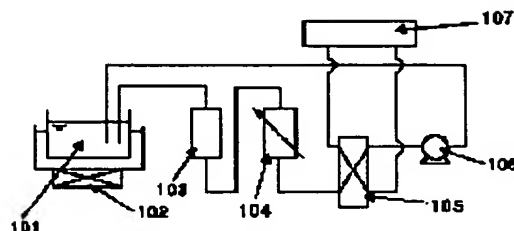
(72)Inventor : OMI TADAIRO
JIZAIMARU TAKAYUKI
NITTA TAKEHISA

(54) METHOD AND SYSTEM FOR WASHING

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To avoid degradation of a washing liquid for a long time while washing effect is excellent, by, with the washing liquid in a bath containing a water-soluble organic solvent irradiated with ultrasonic wave, submerging a base body in it for removing an organic coating adhering to the base body.

SOLUTION: A base body is submerged in a bath of washing liquid comprising a water-soluble organic solvent (acetone, isopropyl alcohol, ethanol, etc.) or its dilution, with an ultrasonic vibrator 102 applied with an voltage. The ultrasonic wave (0.1-10MHz) oscillated from the vibrator 102 is projected on the washing liquid through an outer bath, liquid, an inner bath 101, so that, from a synergetic effect of ultrasonic wave and washing liquid component, a photoresist on the base body at the temperature near room temperature is effectively peeled/removed. The washing liquid is, through a deaeration unit 104, circulated with a pump 106 for deaeration, so cavitation is suppressed, for raised washing effect. At the time, such impurities as peeled resist, etc., are removed with a filter 103, thus re-absorption of particles is prevented.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

(19)日本国特許庁 (J P)

(12) 公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開平10-116809

(43)公開日 平成10年(1998)5月6日

(51)Int.Cl.⁸
H 0 1 L 21/304識別記号
3 4 1F I
H 0 1 L 21/3043 4 1 T
3 4 1 M
3 4 1 NB 0 8 B 3/12
C 1 1 D 7/26B 0 8 B 3/12
C 1 1 D 7/26

A

審査請求 未請求 請求項の数21 O L (全 7 頁) 最終頁に続く

(21)出願番号 特願平8-270353

(22)出願日 平成8年(1996)10月11日

(71)出願人 000205041

大見 忠弘

宮城県仙台市青葉区米ヶ袋2-1-17-
301

(71)出願人 596089517

株式会社ウルトラクリーンテクノロジー開
発研究所

東京都文京区本郷4-1-4

(72)発明者 大見 忠弘

宮城県仙台市青葉区米ヶ袋2の1の17の
301

(74)代理人 弁理士 福森 久夫

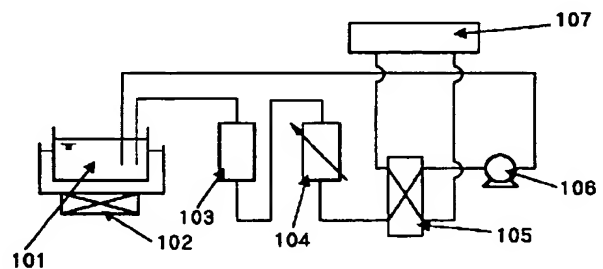
最終頁に続く

(54)【発明の名称】 洗浄方法及び洗浄システム

(57)【要約】

【課題】 フォトリソグロウ等の有機膜を室温で剥離除去することができ、単純な構造の有機物を、他の物質と混合なしに希釈だけで使用するため洗浄液が長時間にわたって劣化せず、しかも洗浄効果が高く、極めて優れた特徴を有する洗浄方法及び洗浄システムを提供することを目的とする。

【解決手段】 水溶性有機溶媒又はその希釈液からなる槽内中の洗浄水に超音波を照射しながら基体を浸漬することにより基体に付着する有機被膜を除去することを特徴とする。あるいは基体に超音波の照射された上記洗浄液を噴射する。水溶性有機溶媒はアセトン、IPA、エタノール等である。イオン注入装置等に隣接して、上記洗浄を行う洗浄装置を設けたことを特徴とする。



【特許請求の範囲】

【請求項 1】 水溶性有機溶媒又はその希釈液からなる槽内中の洗浄水に超音波を照射しながら基体を浸漬することにより基体に付着する有機被膜を除去することを特徴とする洗浄方法。

【請求項 2】 前記水溶性有機溶媒はアセトン、イソプロピルアルコール（以下 IPA）、エタノールのいずれか 1 種であることを特徴とする請求項 1 記載の洗浄方法。

【請求項 3】 請求項 1 又は 2 記載の洗浄後、基体表面に残存した有機物を、酸化による分解により基板から引き離す洗浄方法及び洗浄装置。

【請求項 4】 前記酸化による分解は、オゾン水により行うことを特徴とする請求項 3 記載の洗浄方法。

【請求項 5】 請求項 1 又は 2 記載の洗浄後、基体表面に残存した有機物を、基体表面のスライトエッチングにより基板から引き離すことを特徴とする洗浄方法。

【請求項 6】 前記スライトエッチングはフッ化化合物を含む溶液を用いて行うことを特徴とする請求項 5 記載の洗浄方法。

【請求項 7】 洗浄中に、前記基体を前記洗浄液内外に引き上げ及び引き下げを行うことを特徴とする請求項 1 ないし 6 のいずれか 1 項記載の洗浄方法。

【請求項 8】 洗浄中に、前記基体を洗浄液中で揺動させ、及び／又は前記洗浄液に液中噴流シャワーを供給することを特徴とする請求項 1 ないし 6 のいずれか 1 項記載の洗浄方法。

【請求項 9】 前記洗浄液の入った槽を液体の入った外槽に置き、該外槽に配設した超音波振動子により、前記洗浄液に超音波を間接照射することを特徴とする請求項 1 ないし 8 のいずれか 1 項に記載の洗浄方法。

【請求項 10】 前記洗浄液への超音波の照射は間欠的に行うことを特徴とする請求項 1 ないし 9 のいずれか 1 項に記載の洗浄方法。

【請求項 11】 水溶性有機溶媒又はその希釈液からなる洗浄液に超音波を照射しながら、該洗浄液を基体に供給して基体に付着する有機被膜を除去することを特徴とする洗浄方法。

【請求項 12】 前記基体を回転させることを特徴とする請求項 10 に記載の洗浄方法。

【請求項 13】 前記洗浄液をノズルを介して噴射させて基体に供給することを特徴とする請求項 11 又は 12 記載の洗浄方法。

【請求項 14】 ノズルの吹き出し口は、細い円形で基板の半径方向に往復させる、または、基板の半径方向には線状で円周方向にはきわめてせまい吹き出し口を有するライン状ノズルであり、その吹き出し口の大きさは該洗浄液中の超音波の波長より大きいことを特徴とする請求項 13 記載の洗浄方法。

【請求項 15】 前記超音波の周波数は、0.1～10

MHzであることを特徴とする請求項 1 ないし 14 のいずれか 1 項に記載の洗浄方法。

【請求項 16】 前記有機被膜は、フォトリソグレイであることを特徴とする請求項 1 ないし 15 のいずれか 1 項に記載の洗浄方法。

【請求項 17】 有機被膜を除去した後の洗浄液はフィルタで循環ろ過して再利用することを特徴とする請求項 1 ないし 16 のいずれか 1 項に記載の洗浄方法。

【請求項 18】 前記フィルタは除去可能粒子粒径が異なり、その除去粒子径が次第に小さくなるフィルタを多段に設けることを特徴とする請求項 17 記載の洗浄方法。

【請求項 19】 前記フィルタを少なくとも 2 系統以上設けることを、特徴とする請求項 17 又は 18 記載の洗浄方法。

【請求項 20】 イオン注入装置あるいはリアクティブエッチング装置に隣接して、水溶性有機溶媒又はその希釈液からなる洗浄水を収納する槽と、当該槽中の洗浄水に超音波を照射するための手段とを有する洗浄装置、又は、水溶性有機溶媒又はその希釈液からなる洗浄液に超音波を照射しながら該洗浄液を基体に供給する洗浄装置を設けたことを特徴とする洗浄装置システム。

【請求項 21】 前記洗浄装置とイオン注入装置あるいはリアクティブエッチング装置との間にフォトリソグレイのアッシング装置及び／又はケミカルメカニカルポリッシング（以下 CMP）を設けたことを特徴とする請求項 20 記載の洗浄システム。

【発明の詳細な説明】**【0001】**

【発明の属する技術分野】本発明は、洗浄方法及び洗浄システムに係わり、特にフォトリソグレイ等を室温で剥離、除去可能な洗浄方法及び洗浄システムに関する。

【0002】

【従来の技術】従来、半導体や液晶ディスプレイ製造時におけるレジスト剥離の方法として次の技術が用いられる。硫酸と過酸化水素水とを原液で混合し、この混合した溶液を用いて 100～150℃の高温で処理する方法である。

【0003】また、前述の溶液は強酸性であるために基板の種類によっては基板等に影響を与え使用出来ない場合がある。そのような場合は、高濃度の有機溶剤を用いて高温で処理する方法が用いられている。

【0004】また、フォトリソグレイをマスクとしてイオン注入やリアクティブイオンエッチングを行うと、レジスト表面に大量のイオンが照射され、レジスト材料自身が架橋し硬化するためウェット洗浄では、レジストの除去が困難であり、酸素プラズマあるいは、紫外線（UV）とオゾンガスによりプラズマを導入して、硬化したレジスト部を燃焼除去した後に、残りのレジストを薬品で除去している。

【0005】しかし、硫酸と過酸化水素とを混合した溶液を用いる方法は、高濃度、高温処理のためその洗浄液やシリコンウエハ搬送の操作性が悪い。また、洗浄液中の過酸化水素が分解してしまう結果、寿命が存在し、そのため液の交換及び補充が必要不可欠である。さらに硫酸の廃液処理にコストがかかるという欠点があり、薬品代および廃液処理等のランニングコストに影響が出る。

【0006】有機溶剤を用いる方法も高温プロセスがほとんどであるため操作性が悪く、液質の管理も難しく回収再利用は不可能である。

【0007】プラズマ処理法は、処理後にウエハ上にレジスト中に含まれている金属、微粒子等の汚染物が残存するという欠点である。

【0008】

【発明が解決しようとする課題】本発明は従来の洗浄方法及び洗浄システムの問題を解決し、フォトリジスト等の有機膜を室温で剥離除去することができ、単純な構造の有機物を、他の物質と混合なしに希釈だけで使用するため洗浄液が長時間にわたって劣化せず、しかも洗浄効果が高く、極めて優れた特徴を有する洗浄方法及び洗浄システムを提供することを目的とする。

【0009】

【課題を解決するための手段】本発明の洗浄方法は、水溶性有機溶媒又はその希釈液からなる槽内中の洗浄水に超音波を照射しながら基体を浸漬することにより基体に付着する有機被膜を除去することを特徴とする。

【0010】前記水溶性有機溶媒はアセトン、イソプロピルアルコール（以下IPA）、エタノールが好ましい。また、これらいずれか1種を含む混合液でもよい。

【0011】水溶性有機溶媒の希釈は、純水あるいは超純水で行えばよい。

【0012】なお、水溶性有機溶媒による洗浄のみでは基体表面に有機物が残存した場合には、その有機物を、酸化による分解（例えばオゾン水による分解）により基板から引き離せばよい。

【0013】あるいは、基体表面のスライトエッチングにより基板から引き離してもよい。スライトエッチングは例えば、フッ化合物を含む溶液を用いて行えばよい。

【0014】また、洗浄中に、前記基体を前記洗浄液内外に引き上げ及び引き下げを行うことが好ましい。さらに、洗浄中に、前記基体を洗浄液中で揺動させ、及び／又は前記洗浄液に液中噴流シャワーを供給することが好ましい。

【0015】これにより、洗浄効果は一層高まり、洗浄の均一性を向上して、洗浄時間を短縮することができる。

【0016】また、前記洗浄液の入った槽を液体の入った外槽に置き、該外槽に配設した超音波振動子により、前記洗浄液に超音波を間接照射することを特徴とするこ

とも好ましい。

【0017】これにより、洗浄液の温度を室温付近に保つことができ、高い洗浄効果を維持することができる。

【0018】また、前記洗浄液への超音波の照射は間欠的に行うことによっても洗浄液の温度を室温付近に保つことができ、高い洗浄効果を維持することができる。

【0019】本発明の他の洗浄方法は、水溶性有機溶媒又はその希釈液からなる洗浄液に超音波を照射しながら、該洗浄液を基体に供給して基体に付着する有機被膜を除去することを特徴とする。

【0020】洗浄は、基体を回転させて行うことにより洗浄効果を一段と向上させることができる。

【0021】前記洗浄液はノズルを介して噴射させて基体に供給すればよく、ノズルの吹き出し口は、細い円形で基板の半径方向に往復させる、または、基板の半径方向には線状で円周方向にはきわめてせまい吹き出し口を有するライン状ノズルであり、その吹き出し口の大きさは該洗浄液中の超音波の波長より大きくすることが好ましい。

【0022】洗浄効率を上げるためには超音波の周波数は、0.1～10MHzが好ましい。

【0023】本発明の洗浄システムは、イオン注入装置あるいはリアクティブエッチング装置に隣接して、水溶性有機溶媒又はその希釈液からなる洗浄水を収納する槽と、当該槽中の洗浄水に超音波を照射するための手段とを有する洗浄装置、又は、水溶性有機溶媒又はその希釈液からなる洗浄液に超音波を照射しながら該洗浄液を基体に供給する洗浄装置を設けたことを特徴とする。

【0024】なお、前記洗浄装置とイオン注入装置あるいはリアクティブエッチング装置との間にフォトリジストのアッシング装置及び／又はケミカルメカニカルポリッシャー（以下CMP）を設けてもよい。

【0025】本発明において、室温での洗浄が可能となり、前記洗浄液の温度は、15～40℃の範囲内でコントロールされているが、加熱して使用してもかまわない。

【0026】

【発明の実施の形態】本発明の実施の形態を図1を用いて説明する。

【0027】図1は、本発明の洗浄方法を用いるために、バッチ処理用に用いられる洗浄槽の一例である。

【0028】図1において、101は、有機溶剤及び／又は、純水で希釈された有機溶剤からなる洗浄液を満たした内槽である。102は超音波振動子であり、上部には純水等の液体が満たされている。

【0029】洗浄方法は、基体を洗浄液槽に浸漬し、超音波振動子102に電圧を印加する。振動子から発振される超音波は、外槽、液体、内槽を介して洗浄液に照射され、超音波と洗浄液成分との相乗効果により、室温付近の温度で基体上のフォトリジストが極めて効果的に剥

離除去される。

【0030】洗浄液を103の脱気ユニットを通し106のポンプで循環し、脱気することによりキャビテーションが押さえられ、洗浄効果がいっそう高まる。その際104のフィルターで、剥離されたレジスト等の不純物を取り除き、パーティクルの再吸着を防止する。

【0031】高い洗浄効果が得られる理由の詳細は、現在のところ完全には明らかではないが、次の様に考えられる。まず、イソプロピルアルコールがレジスト内部にまたは、特にレジストと基体の界面に浸透して、レジストを若干溶解、膨張する。その際レジストは超音波によって激しく振動し割れていき基板より剥離するものと考えられる。さらに、超音波によって洗浄液中に生成するラジカル（Hラジカル、OHラジカル）によってレジストと表面の化学結合を切断し、レジストの剥離を促進させる。イソプロピルアルコールを用いることにより、基体とレジストとの界面に浸透しレジストを基板から引き離し、超音波によってレジストが剥離されるものと考えられる。

【0032】なお、レジスト膜を形成する前に、レジスト膜の基板への密着性を高めるために、基板表面の疎水化処理（主に、HMDS（ヘキサメチルジシラザン）処理）が一般的に行われるが、このような密着性を高めた場合であっても本発明の洗浄法により、レジスト膜は効果的に除去される。

【0033】オゾンを用いた洗浄の場合、オゾンに超音波等を印加し、OHラジカルを発生させることによりHMDS処理が行われた面が酸化され分解除去される。

【0034】洗浄は、常温で行うのが好ましいが、加熱装置等を用いて高温で洗浄しても構わない。ただ、その際、液温や、蒸気の管理等難しくなり、ランニングコスト等に影響が生じる。

【0035】なお、洗浄液温度は、超音波のパワー、周波数、照射時間等の、条件によってその上昇する度合いが変化する。温度を所定範囲に保つためには、種々の方法があるが、例えば、図1のように熱交換装置105と、107冷却ユニット用い洗浄液を循環しながら冷却すれば良い。

【0036】超音波の周波数は、0.1~10MHzの範囲が好ましい。超音波が低い周波数では、キャビテーションが発生しやすく半導体素子の形状破壊が起こる場合がある。また周波数が高くなると音圧（振動加速度）が高くなり、フォトリソの除去効果が一層高くなり好ましいが、10MHzを越えると、温度上昇が激しくなり冷却能力の大きな装置が必要となるため、上記範囲とするのが好ましい。

【0037】また、液面付近で高いレジスト除去効果があることから、洗浄中に、基体の引き上げ及び引き下げを行うことが好ましい。これにより、レジスト除去効果は一層向上する。この理由としては、液面においては、

超音波により速い洗浄液の流速が得られること、液面での直進波と反射波との合成波（定在波）の中で、界面近傍の密になった活性部分ができること等により、洗浄効果は高くなると考えられ、基体を界面で上下することでレジストの剥離効果は増加する。

【0038】さらに、基体を左右に揺動させることにより、音波が均一に照射され、洗浄効果をさらに高めることが可能となる。また、洗浄液中に1~2以上のノズルを配置して基板表面に洗浄液を噴射することにより、洗浄効果をさらに高めることが可能となる。

【0039】本発明において、アセトン等有機溶剤濃度は、低濃度では、洗浄効果が低く、高濃度で行うことが好ましい。

【0040】上記した洗浄法ではアセトン、イソプロピルアルコールを用いたが、これに限らず、例えばメチルアルコール、エチルアルコール、2-エトキシエタノール等のアルコール、他のアセトン、メチルエチルケトン等の有機溶剤を用いることができる。但し、洗浄効果および安全性・取り扱い性から、アセトン、もしくはイソプロピルアルコールが最も好ましい。

【0041】また、本発明において、レジスト表面に、パターンを設けることにより、レジストの除去効果を一層高めることができる。

【0042】また、本発明の純水としては、洗浄の対象となる基体の種類によるが不純物を抑えた物が用いられ、半導体基板のフォトリソ除去を行う場合は、0.05μm以上の粒径のパーティクルが数個/ml以下、比抵抗値が18MΩ・cm以上でTOC（全有機炭素）やシリカの値が1ppb以下の超純水が好ましい。

【0043】なお、図1において用いられる純水等の液体は、超音波を効率的に伝搬するために脱気したものをを用いるのが好ましい。また、洗浄液も同様脱気したものをを用いるのが好ましい。気体成分が1ppm以下、より好ましくは50ppb以下である。

【0044】本発明は、必ずしも図1の二槽構成とする必要はなく、一槽構成としてその外壁に振動子を取り付け、直接超音波を洗浄液に照射してもよく、その場合前述したように、間欠照射、あるいは洗浄液を恒温槽との間で循環させることにより温度を一定に保つことができる。振動子も一つに限らず、槽の側壁、底面、上面に設けてもよい。また、洗浄液中に除去されたレジストを循環過程でフィルタにより除去する必要がある。

【0045】次に、本発明の洗浄方法の他の実施の形態図2、3を用いて説明する。

【0046】図2において、201は洗浄液供給装置、202は超音波振動子、203は基体、204は回転装置である。

【0047】これにより、超音波が照射された洗浄液を、回転する基体表面に噴射することにより、遠心力の作用との相乗効果により、レジストが効率よく除去され

る。ここで、ノズルと基体の角度は45度程度とするのが好ましい。ノズルの吹き出し口は円形で、基板の半径方向に往復させてもよいし、基板の半径方向には線状で円周方向には狭い吹き出し口を有するライン状ノズルでも良い。ノズル吹き出し口の大きさは、超音波が効率よく通過するために、洗浄液中の超音波の波長より大きくしておく必要がある。本発明のレジスト除去は、従来の方法のようにレジストを溶解するのではなく、剥離する方法であるから剥離されたレジスト膜の基板への再付着を抑えるために、図2の方法は特に好ましい。吹き出しノズルを複数個設ければ、レジスト剥離はさらに高速で行える。

【0048】図3は、超音波照射された洗浄液をシャワー状に基体に供給する方法であり、上からの物理的な力によってレジストは上から下へ剥離する。また、基体はシャワーに対して平行に配置してもよく、その場合は基体を移動させ、基体全体に均一に洗浄液を供給するのが好ましい。シャワーの吹き出し口は、シャワーの方向を変えるため例えば±15°の範囲で回転往復運動させると有効である。

【0049】図3において、301は洗浄液供給装置付き超音波振動子である。

【0050】本発明は種々のフォトリソの除去に好適であり、耐熱性が高く除去が困難とされているTSMR-8900（東京応化工業株式会社製）についても、極めて高い除去効果を有している。i線用レジスト、エキシマレーザー用レジスト、電子線レジストにも有効である。

【0051】また、本発明はフォトリソに限らず、塗料や接着剤等の種々の高分子有機被膜、機械油等（焼き付いて高分子化した物を含む）の皮膜、界面活性剤や

アセトン濃度 [%]	処理時間 [秒]
100	60
80	70
60	90
40	210
<20	>600

【0058】表1から明らかになるように、アセトン及びIPAと超純水に超音波を照射してもレジストは剥離できるが、高濃度のほうが処理時間が大きく短縮でき、100%で剥離効果は一層向上することが分かった。

【0059】また、比較例として、硫酸・過酸化水素水を用いて、130℃で従来の洗浄を行った。結果を表2に示す。

【0060】

【表2】

染料の除去等に適用できる。

【0052】

【実施例】以下に実施例を挙げて本発明を具体的に説明するが、本発明がこれら実施例に限定されることがないことは言うまでもない。

【0053】（実施例1）図1の洗浄装置を用いて、アセトン、イソプロピルアルコールの濃度とレジスト除去されるまでの時間との関係を調べた。

【0054】本実施例では、基体として、以下の手順でレジストを形成した33mmφのシリコン板を用いた。

【0055】（レジスト形成手順）

①基板プリベーク：150℃、5分

②HMDS（ヘキサメチルジシラザン）塗布：1分30秒

③レジスト（TSMR-8900）塗布：800rpm、2秒、3000rpm、40秒（膜厚：1.0～1.3μm）

④ベーク：90℃、1分30秒

⑤超純水リンス：1分

⑥ポストベーク：130℃、5分

なお、洗浄液は超純水にイソプロピルアルコールを希釈したものを使用した。又、洗浄液の温度は、図1の純水104を恒温槽間で循環して25℃に保った。使用した超音波の周波数は1MHzである。全面にレジストが塗布されたサンプルの除去試験である。

【0056】処理時間は、基体上のレジストが光学顕微鏡観察で、残渣がなくなるまでの時間をレジスト1μm厚さに対して換算した値である。結果を表1に示す。

【0057】

【表1】

IPA濃度 [%]	処理時間 [秒]
100	40
80	55
60	70
40	160
<20	>600

硫酸・過酸化水素水	処理時間 [秒]
4 : 1	600

【0061】（実施例2）図2の洗浄装置を用いて、実施例1と同様にしてフォトリソを形成した6インチシリコンウエハを3000rpmの回転数で回転させ、超音波（1.6MHz）を照射した洗浄液を1リットル／分で供給してレジスト除去の効果を調べたところ、30秒でレジストが除去されるのが確認された。

【0062】また、同様のシリコンウエハを、図3の洗浄装置を用いて、10リットル／分の流量でシャワー供

給してレジスト除去効果を調べたところ、この場合も30秒でレジストが除去されるのが確認された。

【0063】アセトン、IPA等にメガソニック超音波を印加して、レジストを基板表面から剥離する本発明の洗浄装置を、イオン注入装置、リアクティブイオンエッチング(RIE)装置に隣接して設置することはきわめて有効である。イオン注入、RIE工程終了後のレジスト付きウェハは、金属等で汚染されており、ウェハ搬送路、ウェハ搬送ボックスを汚染し、他のウェハへのクロスコンタミネーションの原因となる。したがって、イオン注入、RIE工程終了後ただちに本発明による室温でのレジスト剥離を行い、同じく本発明者がすでに開発している室温ウェット洗浄、乾燥処理を施してから、ウェハ搬送路、ウェハ搬送ボックスに送り込めば、クロスコンタミネーションの問題は、一挙に解決される。

【0064】

【発明の効果】本発明により、即ち、有機溶剤及び／又は、純水で希釈された有機溶剤の洗浄液を用い、メガソニック超音波を照射することによって、基体に付着した有機被膜を剥離除去する洗浄方法により、極めて高い洗浄効果が得られる。

【0065】本発明のレジスト等の有機膜除去は、従来の各種薬品の混合された剥離洗浄薬液によるものではないため液質の変化はほとんど無く、剥離されたレジスト等の有機膜を循環ろ過すれば有機膜はフィルタで除去されてしまうため、洗浄液は殆ど劣化せず長期間に渡る使用が可能である。したがって図2、図3に示される装置で使用後の洗浄液を粗性能フィルタ、中性能フィルタ、高性能フィルタと順次通過させれば再利用できる。

【0066】本発明で、アセトン、IPAが極めて優れたレジスト剥離を有することが確認できた。アセトン、IPA/MSは、SiO₂、PSG、BPSGをまったくエッチングせず極めて望ましい。将来パターンのより一層の微細化が進みエキシマレーザステップ(KrF: 248nm, ArF=193nm)の導入の時代になり、レジストが化学増幅型レジストとなるがアセトン、IPA/MSで問題無く除去出来る。

【0067】レジストの付いた半導体基板は汚染されている。したがって、レジスト付き基板を搬送すると搬送路や搬送ボックス内で異なる基板間のクロスコンタミネーション(相互汚染)の原因となる。

【0068】フォトリソ工程から、次のイオン注入やリアクティブイオンエッチング(RIE)まではレジスト

が本質的に要求される。RIEやイオン注入を終了した基板からは、レジストをただちに除去することが好ましい。

【0069】本発明によるレジスト剥離技術を導入すると引き続く、O₃添加超純水洗浄、界面活性剤添加HF/H₂O₂(メガソニック)洗浄、超純水洗浄との組み合わせにより、全て室温工程でレジスト剥離、表面洗浄が行われ、極めてクリーンな基板が得られる。図1や図2等々に示される洗浄装置にIPAベーパー乾燥やN₂ガスブロー乾燥を導入して、RIEやイオン注入装置直後につなげれば、レジスト付着のない基板だけが搬送される。

【0070】本発明は、特にフォトレジストの剥離に好適に適用され、従来の剥離方法に比べて、高い洗浄除去効果で、清浄な表面とすることができる。さらに、室温付近での処理であるため、取り扱い性・安全性に優れ、しかも廃液処理が容易である。

【0071】従来のRCA洗浄とちがい高温高濃度薬品をいっさい用いない室温ウェット洗浄技術は、すでに開発されている(大見忠弘著、ウルトラクリーンULSI技術、培風館1995年12月刊行)。本発明のレジスト剥離技術と組み合わせることにより、半導体工場、液晶工場から硫酸、塩酸、硝酸、アンモニア等の高濃度薬品を完全に駆逐できる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の洗浄方法を実施するための洗浄装置の一例を示す概念図である。

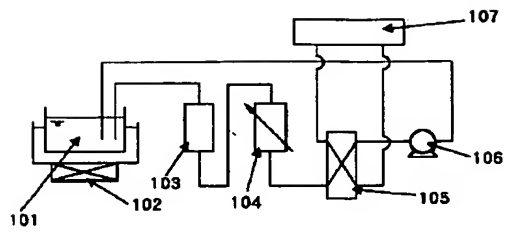
【図2】本発明の洗浄方法を実施するための洗浄装置の一例を示す概念図である。

【図3】本発明の洗浄方法を実施するための洗浄装置の一例を示す概念図である。

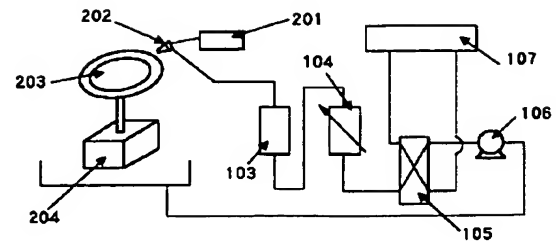
【符号の説明】

- 101 内槽、
- 102 超音波振動子、
- 103 フィルター、
- 104 脱基ユニット、
- 105 熱交換装置、
- 106 循環ポンプ、
- 107 冷却ユニット、
- 201 洗浄液供給装置、
- 202 超音波振動子、
- 203 基体、
- 204 回転テーブル、
- 301 洗浄液供給装置付き超音波振動子。

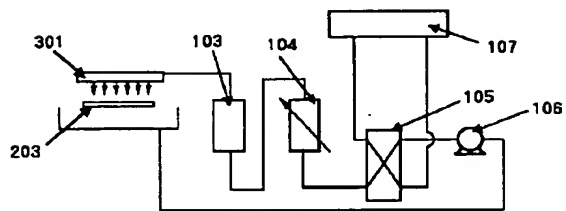
【図 1】



【図 2】



【図 3】



フロントページの続き

(51)Int.Cl.⁶

C 11 D 7/50

H 01 L 21/027

識別記号

F I

C 11 D 7/50

H 01 L 21/30

5 7 2 B

(72)発明者 自在丸 隆行

宮城県仙台市青葉区荒巻字青葉 (無番地)

東北大学工学部電子工学科内

(72)発明者 新田 雄久

東京都文京区本郷4-1-4 株式会社ウル

トラクリーンテクノロジー開発研究所内